

WO 2025/100244 A1

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

processing method comprises bonding together the insulation films of the target substrate and the first die, bonding together electrodes of the target substrate and the first die, bonding together the insulation films of the first die and the second die, and bonding together electrodes of the first die and the second die.

(57) 要約: 基板処理方法は、ターゲット基板の上に第1ダイと第2ダイをこの順番で積層することを有する。前記ターゲット基板は、前記第1ダイとの対向面に絶縁膜と複数の電極とを有する。前記第1ダイは、前記ターゲット基板との対向面に絶縁膜と1つ以上の電極とを有し、且つ前記第2ダイとの対向面に絶縁膜と1つ以上の電極とを有する。前記第2ダイは、前記第1ダイとの対向面に絶縁膜と1つ以上の電極とを有する。前記基板処理方法は、前記ターゲット基板と前記第1ダイの絶縁膜同士を接合することと、前記ターゲット基板と前記第1ダイの電極同士を接合することと、前記第1ダイと前記第2ダイの絶縁膜同士を接合することと、前記第1ダイと前記第2ダイの電極同士を接合することと、を有する。